

Память EEPROM

EEPROM с последовательным доступом, шина I2C

Наименование	Объем памяти, кбайт	Организация памяти	Напряжение питания		Частота SCL, МГц	Корпус	Доступность	Ток потребления в режиме записи, мА	Ток потребления в режиме Standby мкА	Ток потребления в режиме чтения, мА	Время цикла записи, мс	Кол-во циклов стирания/записи, KСycles	Гарантированное время хранения данных, год
			В мин	В макс									
M24128-B	128	16384 × 8	1,8	5,5	0,4	DIP-8;SO-8;TSSOP8	Доступно	0,8–2	1–10	0,8–2	5–10	100	40
M24128-BW	128	16384 × 8	2,5	5,5	0,4	DIP-8;SO-8;TSSOP8	Доступно	1	2	1	5	100	40
M24128-W	128	16384 × 8	2,5	5,5	0,4	SO-8;TSSOP14	В разработке	1	2	1	10	100	40
M24256-A	256	32768 × 8	2,5	5,5	0,4	SO-8	В разработке	1	2	1	10	100	40
M24256-B	256	32768 × 8	4,5	5,5	0,4	DIP-8;SO 8;SO-8	Доступно	2	10	2	5	1000	40
M24256-BV	256	32768 × 8	2,7	3,6	0,4	SO 8;SO-8	Доступно	2	2	2	10	1000	40
M24256-BW	256	32768 × 8	2,5	5,5	0,4	DIP-8;SO 8;SO-8	Доступно	1–2	2	1–2	5	1000	40
M24256-W	256	32768 × 8	2,5	5,5	0,4	SO 8	В разработке	1	2	1	10	100	40
M24512-W	512	65536 × 8	2,5	5,5	0,4	LGA 8;SO 8	Доступно	1	2	1	10	100	40
M24C01	1	128 × 8	4,5	5,5	0,4	SO-8	В разработке	3	5	3	10	1000	40
M24C01-R	1	128 × 8	1,8	5,5	0,4	DIP-8;SO-8;TSSOP8	Доступно	0,8	0,3	0,8	5–10	1000	40
M24C01-W	1	128 × 8	2,5	5,5	0,4	DIP-8;SO-8;TSSOP8	Доступно	1	0,5	1	5	1000	40
M24C02	2	256 × 8	4,5	5,5	0,4	DICE;SO-8	Доступно	3	5	3	5–10	1000	40
M24C02-R	2	256 × 8	1,8	5,5	0,4	SO-8;TSSOP8	Доступно	0,8	0,3	0,8	5	1000	40
M24C02-W	2	256 × 8	2,5	5,5	0,4	DICE;DIP-8;SO-8;TSSOP8	Доступно	1–3	0,5–2	1–3	5	1000	40
M24C04	4	512 × 8	4,5	5,5	0,4	SO-8	В разработке	3	5	3	10	1000	40
M24C04-R	4	512 × 8	1,8	5,5	0,4	DIP-8;SO-8;TSSOP8	В разработке	0,8	0,3	0,8	5	1000	40
M24C04-W	4	512 × 8	2,5	5,5	0,4	DICE;DIP-8;SO-8;TSSOP8	В разработке	1–3	0,5–5	1–3	5	1000	40
M24C08	8	1024 × 8	4,5	5,5	0,4	SO-8	В разработке	2–3	1–5	2–3	5–10	1000	40
M24C08-R	8	1024 × 8	1,8	5,5	0,4	DIP-8;SO-8;TSSOP8	Доступно	0,8	0,3	0,8	5	1000	40
M24C08-S	8	1024 × 8	1,8	3,6	0,4	SO-8	Доступно	0,8	0,3	0,8	10	1000	40
M24C08-W	8	1024 × 8	2,5	5,5	0,4	DIP-8;SO-8;TSSOP8	Доступно	1–3	0,5–5	1–3	5	1000	40
M24C16	16	2048 × 8	4,5	5,5	0,4	SO-8	В разработке	2–3	1–5	2–3	5–10	1000	40
M24C16-R	16	2048 × 8	1,8	5,5	0,4	DIP-8;SO-8;TSSOP8	Доступно	0,8	0,3	0,8	5	1000	40
M24C16-W	16	2048 × 8	2,5	5,5	0,4	DICE;DIP-8;SO-8;TSSOP8	В разработке	1–3	0,5–2	1–3	5	1000	40
M24C32	32	4096 × 8	4,5	5,5	0,4	DIP-8;SO-8	Доступно	2	10	2	5	1000	40
M24C32-R	32	4096 × 8	1,8	5,5	0,4	TSSOP8	Доступно	0,8	0,2	0,8	10	1000	40
M24C32-W	32	4096 × 8	2,5	5,5	0,4	DIP-8;SO-8;TSSOP8	Доступно	1	2	1	5	1000	40
M24C64	64	8192 × 8	1,8	5,5	0,4	DIP-8;SO-8	Доступно	0,8–2	0,2–10	0,8–2	5–10	1000	40
M24C64-R	64	8192 × 8	1,8	5,5	0,4	SO-8	Доступно	0,8	0,2	0,8	10	1000	40
M24C64-W	64	8192 × 8	2,5	5,5	0,4	DIP-8;SO-8;TSSOP8	В разработке	1	2	1	5	1000	40
M34D64-R	64	8192 × 8	1,8	5,5	0,4	SO-8;TSSOP8	Доступно	0,8	0,2	0,8	10	1000	40
M34D64-W	64	8192 × 8	2,5	5,5	0,4	SO-8	Доступно	1	2	1	5	1000	40

EEPROM с последовательным доступом, шина MICROWIRE

Наименование	Объем памяти, кбайт	Организация памяти	Напряжение питания		Частота Serial Clock, МГц	Корпус	Доступность	Ток потребления в режиме записи, мА	Ток потребления в режиме Standby мкА	Ток потребления в режиме чтения, мА	Время цикла записи, мс	Кол-во циклов стирания/записи, KСycles	Гарантированное время хранения данных, лет
			В мин	В макс									
M93C46	1	64×16; 128×8; 64×16; 128×8	4,5	5,5	2	DIP-8;SO-8	В разработке	1,5–2	15–50	1,5–2	5–10	1000	40
M93C46-W	1	64×16; 128×8	2,5	5,5	2	DIP-8;SO-8;TSSOP8	В разработке	1	5–10	1	5–10	1000	40
M93C56	2	128×16; 256×8	4,5	5,5	2	DIP-8;SO-8	В разработке	1,5–2	15–50	1,5–2	5–10	1000	40
M93C56-R	2	128×16; 256×8	1,8	5,5	1	SO-8;TSSOP8	В разработке	1	2	1	10	1000	40
M93C56-W	2	128×16; 256×8	2,5	5,5	2	DIP-8;SO-8;TSSOP8	Доступно	1	5	1	5	1000	40
M93C66	4	256×16; 512×8; 256×16; 512×8	4,5	5,5	2	DIP-8;SO-8	В разработке	1,5–2	15	1,5–2	5–10	1000	40
M93C66-W	4	256×16; 512×8	1,8	5,5	2	DIP-8;SO-8;TSSOP8;VFQFPN 8	В разработке	1	2–5	1	5–10	1000	40
M93C76	8	512×16; 1024×8	4,5	5,5	2	SO-8	Доступно	1,5–2	15–50	1,5–2	5–10	1000	40
M93C76-W	8	512×16; 1024×8	2,5	5,5	2	DIP-8;SO-8;TSSOP8	Доступно	1–2	5–15	1–2	5	1000	40
M93C86	16	1024×16; 2048×8	4,5	5,5	2	DIP-8;SO-8	Доступно	1,5–2	15–50	1,5–2	5–10	1000	40
M93C86-R	16	1024×16; 2048×8	1,8	5,5	1	TSSOP8	В разработке	1	2	1	10	1000	40
M93C86-W	16	1024×16; 2048×8	2,5	5,5	2	DIP-8;SO-8;TSSOP8	Доступно	1	5	1	5	1000	40
M93S46	1	64×16	4,5	5,5	2	DIP-8;SO-8	Доступно	1,5–2	15–50	1,5–2	5–10	1000	40
M93S46-W	1	64×16	2,5	5,5	2	DIP-8;SO-8	В разработке	1	5	1	5	1000	40
M93S56	2	128×16	4,5	5,5	2	DIP-8;SO-8	Доступно	1,5–2	15–50	1,5–2	5–10	1000	40
M93S56-W	2	128×16	2,5	5,5	2	DIP-8;SO-8	В разработке	1	5	1	5	1000	40
M93S66	4	256×16	4,5	5,5	2	DIP-8;SO-8	Доступно	1,5–2	15–50	1,5–2	5–10	1000	40
M93S66-W	4	256×16	2,5	5,5	2	DIP-8;SO-8	Доступно	1	5	1	5	1000	40

Память EEPROM

EEPROM с последовательным доступом, шина SPI

Наименование	Объем памяти, кбайт	Организация памяти	Напряжение питания		Частота Serial Clock, МГц	Корпус	Доступность	Ток потребления в режиме записи, мА	Ток потребления в режиме Standby мкА	Ток потребления в режиме чтения, мА	Время цикла записи, мс	Кол-во циклов стирания/записи, KСycles	Гарантированное время хранения данных, лет
			В мин	В макс									
M95010	1	128×8	4,5	5,5	5	SO-8	В разработке	5	10	5	10	1000	40
M95010-W	1	128×8	2,5	5,5	2	DIP-8;SO-8;TSSOP8	Доступно	2	2	2	10	1000	40
M95020	2	256×8	4,5	5,5	5	SO-8	В разработке	5	10	5	10	1000	40
M95020-W	2	256×8	2,5	5,5	2	DIP-8;SO-8;TSSOP8	Доступно	2	2	2	10	1000	40
M95040	4	256×8;512×8	2,5	5,5	5	SO-8	Доступно	2-5	2-10	2-5	10	1000	40
M95040-W	4	512×8	2,5	5,5	2	DIP-8;SO-8;TSSOP8	Доступно	2	2	2	10	1000	40
M95080	8	1024×8	2,5	5,5	10	DIP-8;SO-8;TSSOP8	Доступно	1-5	0,6-5	1-5	5	1000	40
M95080-W	8	1024×8	2,5	5,5	5	SO-8	Доступно	1	0,6-2	1	5	1000	40
M95128	128	16384×8	2,5	5,5	10	DIP-8;SO-8	В разработке	2-5	2	2	5-10	100	40
M95160	16	2048×8	4,5	5,5	10	SO-8	Доступно	3-5	2-10	3-5	5-10	1000	40
M95160-W	16	2048×8	2,5	5,5	5	DIP-8;SO-8;TSSOP14;TSSOP8	Доступно	1-2	1-2	1-2	5-10	1000	40
M95256	256	32768×8	4,5	5,5	10	SO 8;SO-8	Доступно	4-5	2-5	4-5	5	100	40
M95256-V	256	32768×8	2,7	3,6	5	SO 8	Доступно	3	2	3	10	100	40
M95256-W	256	32768×8	2,5	5,5	5	DIP-8;SO 8;SO-8	Доступно	3	1-2	3	5	100	40
M95320	32	4096×8	4,5	5,5	10	SO-8	Доступно	2-5	2-20	2-5	5-10	100	40
M95320-W	32	4096×8	2,5	5,5	5	DIP-8;SO-8;TSSOP14;TSSOP8	Доступно	3	1-2	3	5	100	40
M95640	64	8192×8	4,5	5,5	10	SO-8	Доступно	2-5	2-20	2-5	5-10	100	40
M95640-W	64	8192×8	2,5	5,5	5	DIP-8;SO-8;TSSOP14;TSSOP8	Доступно	3	1-2	3	5	100	40

Память EPROM и OTP (однократно программируемые)

Напряжение питания 3,3 В

Наименование	Описание	Объем памяти, Мбит	Напряжение питания		Корпус	Время доступа, нс	Доступность	Задержка от Chip Enable до начала считывания, нс	Задержка от Output Enable до начала считывания, нс	Напряжение программирования, В	Ток потребления в режиме программирования, мА
			В мин	В макс							
M27V160	Низковольтное OTP EPROM	16	3	3,6	PDIP 42;PLCC 44	100	Доступно	100	50	12,5	50
M27V320	OTP EPROM	32	3	3,6	TSOP 48	100	Доступно	100	45	-	12
M27V322	Низковольтное OTP EPROM;UV EPROM	32	3	3,6	CDIP 42;PDIP 42	100	Доступно	100	50	12	50

Напряжение питания 5 В

Наименование	Описание	Объем памяти, Мбит	Напряжение питания		Корпус	Время доступа, нс	Доступность	Задержка от Chip Enable до начала считывания, нс	Задержка от Output Enable до начала считывания, нс	Напряжение программирования, В	Ток потребления в режиме программирования, мА
			В мин	В макс							
M27C1001	OTP EPROM;UV EPROM	1	4,5	5,5	CDIP 32;PDIP 32;PLCC 32;TSOP 32	35-120	Доступно	35-120	15-60	12,75	50
M27C1024	OTP EPROM;UV EPROM	1	4,5	5,5	CDIP 40;PDIP 40;PLCC 44	35-120	Доступно	35-120	20-50	12,75	50
M27C160	OTP EPROM;UV EPROM	16	4,5	5,5	CDIP 42;PDIP 42	90-100	Доступно	90-100	45-50	12,5	50
M27C2001	OTP EPROM;UV EPROM	2	4,5	5,5	CDIP 32;PDIP 32;PLCC 32	55-100	Доступно	55-100	30-50	12,75	50
M27C202	OTP EPROM;UV EPROM	2	4,5	5,5	CDIP 40;PDIP 40;PLCC 44	70-100	Доступно	70-100	40-50	12,75	50
M27C256B	OTP EPROM;UV EPROM	0	4,5	5,5	CDIP 28;PDIP 28;PLCC 32	45-120	Доступно	45-120	25-60	12,75	50
M27C322	OTP EPROM;UV EPROM	32	4,5	5,5	CDIP 42;PDIP 42	100	Доступно	100	50	12	50
M27C4001	OTP EPROM;UV EPROM	4	4,5	5,5	CDIP 32;PDIP 32;PLCC 32;TSOP 32	55-100	Доступно	35-100	20-50	12,75	50
M27C4002	OTP EPROM;UV EPROM	4	4,5	5,5	CDIP 40;PDIP 40;PLCC 44	70-120	Доступно	45-120	25-60	12,75	50
M27C512	OTP EPROM;UV EPROM	1	4,5	5,5	CDIP 28;PDIP 28;PLCC 32;TSOP 28	45-120	Доступно	45-120	20-50	12,75	50
M27C64A	UV EPROM	0	4,5	5,5	CDIP 28	-	Доступно	100	50	12,5	30
M27C800	OTP EPROM;UV EPROM	8	4,5	5,5	CDIP 42;PDIP 42	100	Доступно	90-100	45-50	12,5	50
M27C801	OTP EPROM;UV EPROM	8	4,5	5,5	CDIP 32;PDIP 32;PLCC 32	50-100	Доступно	50-100	30-50	12,75	50

FlexibleROM

FlexibleROM

Наименование	Объем памяти, Мбит	Напряжение питания		Организация памяти	Корпус	Время доступа, нс	Доступность	Задержка от Chip Enable до начала считывания, нс	Задержка от Output Enable до начала считывания, нс	Напряжение программирования, В	Ток потребления в режиме программирования, мА
		В мин	В макс								
M27W016	16	2,7	3,6	1x16	PDIP 42;SO 44;TSOP 48	100	Доступно	100	35	12,6	10
M27W032	32	2,7	3,6	2x16	SO 44;TSOP 48	100	Доступно	100	35	12,6	10
M27W064	64	2,7	3,6	4x16	SO 44;TSOP 48	100	Доступно	100	35	12,6	10

Tiger Range, напряжение питания 3 В

Наименование	Описание	Объем памяти, Мбит	Напряжение питания		Корпус	Время доступа, нс	Доступность	Задержка от Chip Enable до начала считывания, нс	Задержка от Output Enable до начала считывания, нс	Напряжение программирования, В	Ток потребления в режиме программирования, мА
			В мин	В макс							
M27W101	Низковольтный OTP EPROM	1	3	3,6	PLCC 32;TSOP 32	80	Доступно	80	50	12,75	50
M27W102	Низковольтный OTP EPROM	1	3	3,6	PLCC 44;TSOP 40	80	Доступно	80	50	12,75	50
M27W201	Низковольтный OTP EPROM; низковольтный UV EPROM	2	3	3,6	CDIP 32;PDIP 32; PLCC 32;TSOP 32	80	Доступно	80	50	12,75	50
M27W202	Низковольтный OTP EPROM	2	3	3,6	PLCC 44	100	Доступно	100	60	12,75	50
M27W401	Низковольтный OTP EPROM	4	3	3,6	PDIP 32;PLCC 32; TSOP 32	80	Доступно	80	50	12,75	50
M27W402	Низковольтный OTP EPROM	4	3	3,6	PDIP 40;PLCC 44	100	Доступно	100	60	12,75	50
M27W512	Низковольтный OTP EPROM	1	3	3,6	PLCC 32;TSOP 28	100	Доступно	100	60	12,75	50
M27W800	Низковольтный OTP EPROM	8	2,7	3,6	PLCC 32;PLCC 44	100	Доступно	100	50	12,5	50

Flash-память

Flash-память, Boot block, 1.8 В

Наименование	Объем памяти, кбайт	Организация памяти	Напряжение питания		Корпус	Доступность	Boot Block	Время цикла чтения	Время стирания сектора	Время записи слова, мкс	Ток потребления в режиме Standby, мкА	Ток потребления в режиме стирания, мкА	Ток потребления в режиме программирования, мА	Кол-во циклов стирания/записи, мирования	Гарантированное время хранения данных, лет
			В мин	В макс											
M28R400CB	4	256Kx16	1,65	2,2	BGA 46	Доступно	Младшие адреса	120	1000	10	50	20	20	100000	20
M28R400CB-KGD	4	256Kx16	1,65	2,2	DICE	В разработке	Младшие адреса	120	1000	10	50	20	20	100000	20
M28R400CT	4	256Kx16	1,65	2,2	BGA 46	Доступно	Старшие адреса	120	1000	10	50	20	20	100000	20

Flash-память, Burst Mode

Наименование	Объем памяти, кбайт	Организация памяти	Напряжение питания		Корпус	Доступность	Boot Block	Время цикла чтения, нс	Время стирания сектора, мс	Время записи слова, мкс	Ток потребления в режиме Standby, мкА	Ток потребления в режиме стирания, мА	Ток потребления в режиме программирования, мА	Кол-во циклов стирания/записи	Гарантированное время хранения данных, лет
			В мин	В макс											
M58BW016BV	16	512Kx32	2,7	3,6	PQFP 80	В разработке	Младшие адреса	70-80	1500	30	60	30	30	100000	20

Flash - память, Dual Bank Page Mode

Наименование	Объем памяти, кбайт	Организация памяти	Напряжение питания		Корпус	Доступность	Режим	Boot Block	Время цикла чтения, нс	Время стирания сектора, мс	Время записи слова, мкс	Ток потребления в режиме Standby, мкА	Ток потребления в режиме стирания, мА	Ток потребления в режиме программирования, мА	Гарантированное время хранения данных, лет
			В мин	В макс											
M59DR032A	32	2Mx16	1,65	2,2	BGA 48	Доступно	Страничный	Старшие адреса	120	1000	10	50	20	20	20
M59DR032EA	32	2Mx16	1,65	2,2	BGA 48	В разработке	Страничный	Старшие адреса	85-100	800	10	50	20	20	20

Flash-память

Flash - память, High Performance

Наименование	Объем памяти, кбайт	Организация памяти	Напряжение питания		Корпус	Доступность	Режим	Boot Block	Время цикла чтения, нс	Время стирания сектора, мс	Время записи слова, мкс	Ток потребления в режиме Standby, мкА	Ток потребления в режиме стирания, мА	Ток потребления в режиме программирования, мА	Гарантированное время хранения данных, лет
			В мин	В макс											
M58LW032C	32	2M×16	2,7	3,6	BGA 64; TSOP 56	В разработке	Burst	Универсальный	90 - 110	1200	16	40	30	30	20
M58LW064C	64	4M×16	2,7	3,6	BGA 64; TSOP 56	Доступно	Burst	Универсальный	110	1200	16	40	30	30	20

Flash-память, Light Flash

Наименование	Объем памяти, кбайт	Организация памяти	Напряжение питания		Корпус	Доступность	Режим	Boot Block	Время цикла чтения, нс	Время стирания сектора, мс	Время записи слова, мкс	Ток потребления в режиме Standby, мкА	Ток потребления в режиме стирания, мА	Ток потребления в режиме программирования, мА	Гарантированное время хранения данных, лет
			В мин	В макс											
M29KW016E	16	1M×16	2,7	3,6	TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Универсальный	90	1500	9	100	20	20	20
M29KW032E	4	×16	-	-	TSOP 48	Доступно	-	-	90	-	9	-	-	-	-
M29KW064E	64	4M×16	2,7	3,6	TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Универсальный	90	1500	9	100	20	20	20
M59PW016	16	1M×16	2,7	3,6	SO 44	Доступно	-	-	-	1500	9	100	20	20	20
M59PW032	32	2M×16	2,7	3,6	SO 44; TSOP 48	Доступно	-	-	-	1500	9	100	20	20	20
M59PW064	64	4M×16	2,7	3,6	SO 44; TSOP 48	Доступно	-	-	-	1500	9	100	20	20	20
M59PW1282	128	2×(4M×16)	2,7	3,6	SO 44	Доступно	-	-	-	1500	9	100	20	20	20

Flash - память, Multiple Bank Burst Mode

Наименование	Объем памяти, кбайт	Организация памяти	Напряжение питания		Корпус	Доступность	Режим	Boot Block	Время цикла чтения, нс	Время стирания сектора, мс	Время записи слова, мкс	Ток потребления в режиме Standby, мкА	Ток потребления в режиме стирания, мА	Ток потребления в режиме программирования, мА	Гарантированное время хранения данных, лет
			В мин	В макс											
M58CR032C	32	2M×16	1,65	2	BGA 56	Доступно	Burst	Старшие адреса	100	1100	10	50	20	20	20
M58CR032D	32	2M×16	1,65	2	BGA 56	Доступно	Burst	Младшие адреса	100	1100	10	50	20	20	20
M58CR064C	64	4M×16	1,65	2	BGA 56	Доступно	Burst	Старшие адреса	90	1100	10	50	20	20	20
M58CR064P	64	4M×16	1,65	2	BGA 56	Доступно	Burst	Старшие адреса	90	1100	10	50	20	20	20
M58WR032EB	32	2M×16	1,65	2,2	VFBGA 56	Доступно	-	Младшие адреса	70	1100	10	50	20	20	20
M58WR032ET	32	2M×16	1,65	2,2	VFBGA 56	Доступно	-	Старшие адреса	70	1100	10	50	20	20	20
M58WR064EB	64	4M×16	1,65	2,2	VFBGA 56	Доступно	Burst	Младшие адреса	70	1100	10	50	20	20	20
M58WR064ET	64	4M×16	1,65	2,2	VFBGA 56	Доступно	Burst	Старшие адреса	70	1100	10	50	20	20	20

Flash-память, Flash NAND, страница 528 байт

Наименование	Объем памяти, Мбайт	Организация массива	Напряжение питания		Корпус	Доступность	Время цикла чтения, нс	Время цикла записи, нс	Время стирания блока, мс	Время записи страницы, мкс	Ток потребления в режиме чтения, мА	Ток потребления в режиме Standby, мА	Ток потребления в режиме стирания, мкА	Ток потребления в режиме программирования, мА	Кол-во циклов стирания/записи/программирования	Гарантированное время хранения данных, лет
			В мин	В макс												
NAND01GW3A	1024	Страница 528 байт, для шины 8 бит	2,7	3,6	TSOP 48	В разработке	50	50	2	200	20	100	20	20	100000	10
NAND128W4A	128		2,7	3,6	TSOP 48	В разработке	50	50	2	200	20	50	20	20	100000	10
NAND256R3A	256	Страница 528 байт, для шины 8 бит	1,7	1,95	CDIP 32	В разработке	60	60	2	200	15	50	15	15	100000	10
NAND256W3A	256	Страница 528 байт, для шины 8 бит	2,7	3,6	TSOP 48	В разработке	50	50	2	200	20	50	20	20	100000	10
NAND512W3A	512	Страница 528 байт, для шины 8 бит	2,7	3,6	TSOP 48; VFBGA 63	В разработке	50	50	2	200	20	50	20	20	100000	10

Flash-память

Flash - память (индустриальный стандарт), Boot Block, 3 В

Наименование	Объем памяти, Мбит	Организация массива	Напряжение питания		Корпус	Доступность	Режим	Boot Block	Время цикла записи, нс	Время стирания сектора, мс	Время записи слова, мкс	Ток потребления в режиме Standby, мкА	Ток потребления в режиме стирания, мА	Ток потребления в режиме программирования, мА	Гарантированное время хранения данных, лет
			В мин	В макс											
M28W160BB	16	1M×16	2,7	3,6	BGA 46	В разработке	–	Младшие адреса	100	–	10	50	20	20	20
M28W160BT	16	1M×16	2,7	3,6	BGA 46; 46 MICRO	Доступно	–	Старшие адреса	90–100	1–1000	10	50	20	20	20
M28W160CB	16	1M×16	2,7	3,6	BGA 46; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	70–100	1000	10	50	20	20	20
M28W160CT	16	1M×16	2,7	3,6	BGA 46; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Старшие адреса	70–90	1000	10	50	20	20	20
M28W160EC	16	–	2,7	3,6	TSOP 48	В разработке	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M28W160ECB	16	–	2,7	3,6	BGA 46	Доступно	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M28W320CB	32	2M×16	2,7	3,6	TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	70–90	1000	10	50	20	20	20
M28W320CT	32	2M×16	2,7	3,6	BGA 47; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Старшие адреса	70–90	1000	10	50	20	20	20
M28W320EBT	32	2M×16	2,7	3,6	BGA 47	Доступно	Асинхронный	Старшие адреса	70–100	1000	10	50	20	20	20
M28W320ECB	32	2M×16	2,7	3,6	BGA 47	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	70	–	10	50	20	20	20
M28W320ECT	32	2M×16	2,7	3,6	BGA 47	Доступно	Асинхронный	Старшие адреса	70	–	10	50	20	20	20
M28W640ECB	64	4M×16	2,7	3,6	BGA 48; TSOP 48	В разработке	Асинхронный	Младшие адреса	70	–	10	50	20	20	20
M28W640ECT	64	4M×16	2,7	3,6	BGA 48; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Старшие адреса	70	–	10	50	20	20	20
M28W800BB	8	521K×16	2,7	3,6	BGA 46	В разработке	Асинхронный	Младшие адреса	85–90	–	10	50	20	20	20
M28W800CB	8	521K×16	2,7	3,6	BGA 46; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	70–90	1000	10	50	20	20	20
M28W800CT	8	521K×16	2,7	3,6	BGA 46; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Старшие адреса	70–90	1–1000	10	50	20	20	20

Flash - память (индустриальный стандарт), High Performance

Наименование	Объем памяти, Мбит	Организация памяти	Напряжение питания		Корпус	Доступность	Режим	Boot Type	Время цикла чтения, нс	Время стирания сектора, мс	Время записи слова, мкс	Ток потребления в режиме Standby, мкА	Ток потребления в режиме стирания, мА	Ток потребления в режиме программирования, мА	Гарантированное время хранения данных, лет
			В мин	В макс											
M58LW032D	32	2M×16, 4M×8	2,7	3,6	BGA 64; TSOP 56	Доступно	Асинхронный	Универсальный	90–110	1200	16	40	30	30	20
M58LW064D	64	4M×16, 8M×8	2,7	3,6	BGA 64; TSOP 56	Доступно	Асинхронный	Универсальный	110	1200	16	40	30	30	20
M58LW128H	128	8M×16	2,7	3,6	BGA 64	В разработке	Burst	Универсальный	115	1200	16	40	30	30	20

Flash-память (индустриальный стандарт), 3 В

Наименование	Объем памяти, Мбит	Организация памяти	Напряжение питания		Корпус	Доступность	Режим	Boot Type	Время цикла чтения, нс	Время стирания сектора, мс	Время записи слова, мкс	Ток потребления в режиме Standby, мкА	Ток потребления в режиме стирания, мА	Ток потребления в режиме программирования, мА	Гарантированное время хранения данных, лет
			В мин	В макс											
M29DW323DB	32	2M×16, 4M×8	2,7	3,6	BGA 48; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	70–90	800	10	100	20	20	20
M29DW323DT	32	2M×16, 4M×8	2,7	3,6	BGA 48; BGA 63; TSOP 48	В разработке	Асинхронный	Старшие адреса	70	800	10	100	20	20	20
M29DW324DB	32	2M×16, 4M×8	2,7	3,6	BGA 48; TSOP 48	В разработке	Асинхронный	Младшие адреса	70	800	10	100	20	20	20
M29DW324DT	32	2M×16, 4M×8	2,7	3,6	BGA 63; TSOP 48	В разработке	Асинхронный	Старшие адреса	70	800	10	100	20	20	20
M29DW640D	64	4M×16, 8M×8	2,7	3,6	TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Универсальный	90	800	10	100	20	20	20
M29W004BB	4	512K×8	2,7	3,6	TSOP 40	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	90–120	800	10	100	20	20	20
M29W004BT	4	512K×8	2,7	3,6	TSOP 40	В разработке	Асинхронный	Старшие адреса	70–120	800	10	100	20	20	20
M29W008AB	8	1M×8	2,7	3,6	TSOP 40	Saturation	Асинхронный	Младшие адреса	90	1500	10	100	20	20	20
M29W010B	1	128K×8	2,7	3,6	PLCC 32; TSOP 32	Доступно	Асинхронный	Универсальный	70–90	400	10	100	20	20	20

Flash-память

Flash-память (индустриальный стандарт), 3 В

Наименование	Объем памяти, Мбит	Организация памяти	Напряжение питания		Корпус	Доступность	Режим	Boot Type	Время цикла чтения, нс	Время стирания сектора, мс	Время записи слова, мкс	Ток потребления в режиме Standby, мкА	Ток потребления в режиме стирания, мА	Ток потребления в режиме программирования, мА	Гарантированное время хранения данных, лет
			В мин	В макс											
M29W040B	4	512K×8	2,7	3,6	PLCC 32; TSOP 32	Доступно	Асинхронный	Универсальный	55–120	800	10	100	20	20	20
M29W102BB	1	64K×16	2,7	3,6	TSOP 40	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	50–70	800	10	100	20	20	20
M29W160DB	16	1M×16, 2M×8	2,7	3,6	TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	90	800	13	100	20	20	20
M29W160DT	16	1M×16, 2M×8	2,7	3,6	TSOP 48	В разработке	Асинхронный	Старшие адреса	70–90	800	13	100	20	20	20
M29W160EB	16	1M×16, 2M×8	2,7	3,6	BGA 48; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	70–90	800	13	100	20	20	20
M29W160ET	16	1M×16, 2M×8	2,7	3,6	BGA 48; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Старшие адреса	70–90	800	13	100	20	20	20
M29W200BB	2	128K×16, 256K×8	2,7	3,6	SO 44; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	55–90	800	10	100	20	20	20
M29W200BT	2	128K×16, 256K×8	2,7	3,6	SO 44; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Старшие адреса	55–90	800	10	100	20	20	20
M29W320DB	32	2M×16, 4M×8	2,7	3,6	BGA 63; TSOP 48	В разработке	Асинхронный	Младшие адреса	70–90	800	10	100	20	20	20
M29W320DT	32	2M×16, 4M×8	2,7	3,6	BGA 63; TSOP 48	В разработке	Асинхронный	Старшие адреса	70–90	800	10	100	20	20	20
M29W400BB	4	256K×16, 512K×8	2,7	3,6	SO 44; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	55–120	800	10	100	20	20	20
M29W400BT	4	256K×16, 512K×8	2,7	3,6	SO 44; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Старшие адреса	55–120	800	10	100	20	20	20
M29W400DB	4	256K×16, 512K×8	2,7	3,6	BGA 48; SO 44; TSOP 48	В разработке	Асинхронный	Младшие адреса	45–70	800	10	100	20	20	20
M29W400DT	4	256K×16, 512K×8	2,7	3,6	SO 44; TSOP 48	В разработке	Асинхронный	Старшие адреса	45–70	800	10	100	20	20	20
M29W640DB	64	4M×16, 8M×8	2,7	3,6	BGA 63; TSOP 48	В разработке	Асинхронный	Младшие адреса	90	800	10	100	20	20	20
M29W640DT	64	4M×16, 8M×8	2,7	3,6	BGA 63; TSOP 48	В разработке	Асинхронный	Старшие адреса	90	800	10	100	20	20	20
M29W800DB	8	512K×16, 1M×8	2,7	3,6	SO 44; TSOP 4	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	70–90	800	10	100	20	20	20
M29W800DT	8	512K×16, 1M×8	2,7	3,6	SO 44; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Старшие адреса	70–90	800	10	100	20	20	20

Flash-память (индустриальный стандарт), 5 В

Наименование	Объем памяти, Мбит	Организация памяти	Напряжение питания		Корпус	Доступность	Режим	Boot Type	Время цикла чтения, нс	Время стирания сектора, мс	Время записи слова, мкс	Ток потребления в режиме Standby, мкА	Ток потребления в режиме стирания, мА	Ток потребления в режиме программирования, мА	Гарантированное время хранения данных, лет
			В мин	В макс											
M29F002BB	2	256K×8	4,5	5,5	PDIP 32; PLCC 32; TSOP 32	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	70–90	600	8	100	20	20	20
M29F002BT	2	256K×8	4,5	5,5	PLCC 32; TSOP 32	Доступно	Асинхронный	Старшие адреса	45–70	600	8	100	20	20	20
M29F010B	1	128K×8	4,5	5,5	PLCC 32; TSOP 32	Доступно	Асинхронный	Универсальный	45–120	300	8	100	20	20	20
M29F016D	16	2M×8	4,5	5,5	SO 44; TSOP 40	Доступно	Асинхронный	Универсальный	55–90	800	10	150	20	20	20
M29F032D	32	4M×8	4,5	5,5	TSOP 40	В разработке	Асинхронный	Универсальный	70	800	10	150	20	20	20
M29F040B	4	512K×8	4,5	5,5	PDIP 32; PLCC 32; TSOP 32	Доступно	Асинхронный	Универсальный	45–120	600	8	100	20	20	20
M29F080D	8	1M×8	4,5	5,5	SO 44; TSOP 40	Доступно	Асинхронный	Универсальный	55–90	800	10	150	20	20	20
M29F100BB	1	64K×16, 128K×8	4,5	5,5	SO 44; TSOP 48	В разработке	Асинхронный	Младшие адреса	90	600	8	100	20	20	20
M29F100BT	1	64K×16, 128K×8	4,5	5,5	SO 44	В разработке	Асинхронный	Старшие адреса	90	600	8	100	20	20	20
M29F102BB	1	64K×16	4,5	5,5	TSOP 40	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	35–70	600	8	100	20	20	20
M29F200BB	2	128K×16, 256K×8	4,5	5,5	SO 44; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	45–90	600	8	100	20	20	20
M29F200BT	2	128K×16, 256K×8	4,5	5,5	SO 44; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Старшие адреса	45–70	600	8	100	20	20	20
M29F400BB	4	256K×16, 512K×8	4,5	5,5	SO 44; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	45–120	600	8	100	20	20	20

Flash-память

Flash-память (индустриальный стандарт), 5 В

Наименование	Объем памяти, Мбит	Организация памяти	Напряжение питания		Корпус	Доступность	Режим	Boot Type	Время цикла чтения, нс	Время стирания сектора, мс	Время записи слова, мкс	Ток потребления в режиме Standby, мкА	Ток потребления в режиме стирания, мА	Ток потребления в режиме программирования, мА	Гарантированное время хранения данных, лет
			В мин	В макс											
M29F400BT	4	256K×16, 512K×8	4,5	5,5	SO 44; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Старшие адреса	45–90	600	8	100	20	20	20
M29F800DB	8	512K×16, 1M×8	4,5	5,5	SO 44; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Младшие адреса	55–90	800	10	150	20	20	20
M29F800DT	8	512K×16, 1M×8	4,5	5,5	SO 44; TSOP 48	Доступно	Асинхронный	Старшие адреса	55–70	800	10	150	20	20	20

Flash-память, для BIOS персональных ПК и серверов

Наименование	Объем памяти, Мбит	Организация памяти	Напряжение питания		Корпус	Доступность	Время цикла чтения, нс	Время стирания сектора, мс	Время записи слова, мкс	Ток потребления в режиме стирания, мА	Ток потребления в режиме программирования, мА
			В мин	В макс							
M50FLW040A	4	{2×(16×4K)+(5×64K)+1×(16×4K)}×8	3	3,6	PLCC 32;TSOP 40	В разработке	250	400	10	20	20
M50FLW040B	4	{1×(16×4K)+(5×64K)+2×(16×4K)}×8	3	3,6	PLCC 32;TSOP 40	В разработке	250	400	10	20	20
M50FLW080A	8	{2×(16×4K)+(13×64K)+1×(16×4K)}×8	3	3,6	TSOP 32	В разработке	250	400	10	20	20
M50FLW080B	8	{1×(16×4K)+(13×64K)+2×(16×4K)}×8	3	3,6	TSOP 32	В разработке	250	400	10	20	20
M50FW002	2	256K×8	3	3,6	PLCC 32	В разработке	250	1000	10	20	20
M50FW016	16	(32×64K)×8	3	3,6	TSOP 40	Доступно	250	1000	10	–	–
M50FW040	4	(8×64K)×8	3	3,6	PLCC 32;TSOP 40	Доступно	250	1000	10	20	20
M50FW080	8	(16×64K)×8	3	3,6	PLCC 32;TSOP 40	Доступно	250	1000	10	20	20
M50LPW040	4	(8×64K)×8	3	3,6	PLCC 32;TSOP 40	Доступно	250	1000	10	20	20
M50LPW080	8	(16×64K)×8	3	3,6	PLCC 32;TSOP 40	Доступно	250	1000	10	20	20
M50LPW116	16	((16K+(2×8K)+32K+(30×64K)+(16×4K))×8	3	3,6	TSOP 40	Доступно	250	1000	10	20	20

Flash-память, с последовательным доступом для хранения программ

Наименование	Объем памяти, байт	Организация памяти	Напряжение питания		Доступность	Корпус	Время цикла записи страницы, мс	Время цикла стирания сектора, мс	Частота SCL, МГц	Ток потребления в режиме Standby, мкА	Размер сектора (стирание), байт	Размер страницы (запись), байт	Кол-во циклов стирания/	Гарантированное время хранения данных, лет
			В мин	В макс										
M25P05-AV	65536	65536×8	2,7	3,6	В разработке	SO-8;VFQFPN 8	1,4–2	800–2000	40	1–5	32768	256	100000	20
M25P10-AV	131072	131072×8	2,7	3,6	Доступно	SO-8;VFQFPN 8	1,4–2	800–2000	40	1–5	32768	256	100000	20
M25P16-V	2097152	2097152×8	2,7	3,6	В разработке	MONTGOMERYVILLE 2; SO-16L	1,4	1000	50	10	65536	256	100000	20
M25P20-V	262144	262144×8	2,7	3,6	Доступно	SO-8;VFQFPN 8	1,4	800	40	5	65536	256	100000	20
M25P32-V	4194304	4194304×8	2,7	3,6	В разработке	MONTGOMERYVILLE 2; SO-16L	1,4	1000	50	10	65536	256	100000	20
M25P40-V	524288	524288×8	2,7	3,6	В разработке	PowerFLAT (6x5 mm); SO-8;VFQFPN 8	1,4	1000	40	10	65536	256	100000	20
M25P80-V	1048576	1048576×8	2,7	3,6	В разработке	SO 8;VFQFPN 8	1,4	1000	40	10	65536	256	100000	20

Flash-память, с последовательным доступом для хранения данных

Наименование	Объем памяти, байт	Напряжение питания		Доступность	Корпус	Время цикла записи страницы, мс	Время цикла стирания сектора, мс	Частота SCL, МГц	Ток потребления в режиме чтения, мА	Ток потребления в режиме Standby, мкА	Размер страницы, байт	Размер сектора, байт	Кол-во циклов стирания/	Гарантированное время хранения данных, лет
		В мин	В макс											
M45PE40-V	524288	2,7	3,6	В разработке	VFQFPN 8	1,2	1000	25	6	1	256	65536	100000	20
M45PE80-V	1048576	2,7	3,6	В разработке	VFQFPN 8	1,2	1000	25	6	1	256	65536	100000	20

Память – NVRAM и часы реального времени

Часы реального времени с последовательным доступом

Наименование	Организация памяти	Особенности	Напряжение питания		Доступность	Корпус	Интерфейс	Ток потребления от батареи, нА
			В мин	В макс				
M41ST84W	512b (×8)		2,7	3,3	Доступно	SO-16	I2C	500
M41ST84Y	512b (×8)		4,5	5,5	Доступно	SO-16	I2C	500
M41ST85W	512b (×8)	Встроенный кварц	2,7	3,3	Доступно	SO 28	I2C	500
M41ST85Y	512b (×8)	Встроенный кварц	4,5	5,5	Доступно	SO 28	I2C	500
M41ST87W	1280b (×8)	Встроенный кварц	2,7	3,6	Доступно	SO 28	I2C	700
M41ST87Y	1280b (×8)	Встроенный кварц	4,5	5,5	Доступно	SO 28	I2C	700
M41ST95W	512 бит (64 бит × 8)	Встроенный кварц	2,7	3,6	Доступно	SO 28	SPI	700
M41T0	–	Встроенный кварц	2	5,5	Доступно	SO-8;TSSOP8	I2C	–
M41T00	64b (×8)		2	5,5	Доступно	SO-8	I2C	1000
M41T11	512b (×8)		2	5,5	Доступно	SO 28;SO-8	I2C	1000
M41T256Y	32Kb (×8)		4,5	5,5	Доступно	SO 44	I2C;I2C (400 кГц)	–
M41T315V	–		3	3,6	Доступно	SO 28;SO-16	Последовательный	500000
M41T315Y	–		4,5	5,5	Доступно	SO-16	Последовательный	500000
M41T50	–	Встроенный кварц	1,7	3,6	В разработке	QFN16 (3×3 мм)	I2C	–
M41T56	512b (×8)		4,5	5,5	Доступно	SO 28;SO-8	I2C	550
M41T60	–		1,3	3,6	В разработке	QFN16 (3×3 мм)	I2C	–
M41T62	–		1,3	3,6	В разработке	QFN16 (3×3 мм)	I2C	–
M41T65	–		1,3	3,6	В разработке	QFN16 (3×3 мм)	I2C	–
M41T80	512b (×8)		2	5,5	Доступно	SO-8	I2C	–
M41T81	512b (×8)		2	5,5	Доступно	SO 28;SO-8	I2C	1000
M41T94	512b (×8)		2,7	5,5	Доступно	SO 28;SO-16	I2C	500

TIMEKEEPER

Наименование	Организация памяти	Напряжение питания		Доступность	Корпус	Интерфейс	Количество портов	Наличие RTC ввода/вывода
		В мин	В макс					
M440T1MV	32 Мбит (1024 Кбит × 32)	3	3,6	Доступно	BGA 168	Параллельный	32	Да
M440T513Y	16 Мбит (512 Кбит × 32)	4,5	5,5	Доступно	BGA 168	Параллельный	32	Да
M48T02	2Kb×8	4,75	5,5	Доступно	PDIP 24	Параллельный	8	Да
M48T08	8Kb×8	4,75	5,5	Доступно	PDIP 28	Параллельный	8	Да
M48T08Y	8Kb×8	4,5	5,5	Доступно	SO 28	Параллельный	8	Да
M48T12	2Kb×8	4,5	5,5	Доступно	PDIP 24	Параллельный	8	Да
M48T128Y	128Kb×8	4,75	5,5	Доступно	MISC. 32	Параллельный	8	Да
M48T129V	128Kb×8	3	3,6	Доступно	MISC. 32	Параллельный	8	Да
M48T129Y	128Kb×8	4,5	5,5	Доступно	MISC. 32	Параллельный	8	Да
M48T18	8Kb×8	4,5	5,5	Доступно	PDIP 28	Параллельный	8	Да
M48T248Y	1Mb×8	4,5	5,5	Доступно	MISC. 32	Параллельный	8	Да
M48T251Y	4Mb×8	4,5	5,5	Доступно	MISC. 32	Параллельный	8	Да
M48T254V	16Mb×8	3	3,6	Доступно	BGA 168	Параллельный	8	Да
M48T35	32Kb×8	4,75	5,5	Доступно	PDIP 28	Параллельный	8	Да
M48T35AV	32Kb×8	3	3,6	Доступно	PDIP 28;SO 28	Параллельный	8	Да
M48T35Y	32Kb×8	4,5	5,5	Доступно	PDIP 28;SO 28	Параллельный	8	Да
M48T37V	32Kb×8	3	3,6	Доступно	SO 44	Параллельный	8	Да
M48T37Y	32Kb×8	4,5	5,5	Доступно	SO 44	Параллельный	8	Да
M48T512Y	512Kb×8	4,5	5,5	Доступно	MISC. 32	Параллельный	8	Да
M48T559Y	8Kb×8	4,5	5,5	В разработке	SO 28	Параллельный	8	Да
M48T58	8Kb×8	4,75	5,5	Доступно	PDIP 28	Параллельный	8	Да
M48T58Y	8Kb×8	4,5	5,5	Доступно	PDIP 28;SO 28	Параллельный	8	Да
M48T59Y	8Kb×8	4,5	5,5	Доступно	PDIP 28;SO 28	Параллельный	8	Да
M48T86	1Kb×8	4,5	5,5	Доступно	PDIP 24;SO 28	Параллельный	8	Да

ZEROPOWER

Наименование	Организация памяти	Напряжение питания		Доступность	Корпус	Интерфейс	Количество портов ввода/вывода
		В мин	В макс				
M48Z02	2Kb×8	4,75	5,5	Доступно	PDIP 24	Параллельный	8
M48Z08	8Kb×8	4,75	5,5	Доступно	PDIP 28	Параллельный	8
M48Z12	2Kb×8	4,5	5,5	Доступно	PDIP 24	Параллельный	8
M48Z128	128Kb×8	4,75	5,5	Доступно	MISC. 32	Параллельный	8
M48Z128Y	128Kb×8	4,5	5,5	Доступно	MISC. 32	Параллельный	8
M48Z129V	128Kb×8	3	3,6	Доступно	MISC. 32	Параллельный	8
M48Z18	8Kb×8	4,5	5,5	Доступно	PDIP 28	Параллельный	8
M48Z2M1V	2Mb×8	3	3,6	Доступно	MISC. 36	Параллельный	8
M48Z2M1Y	2Mb×8	4,5	5,5	Доступно	MISC. 36	Параллельный	8
M48Z32V	32Kb×8	3	3,6	Доступно	SO 44	Параллельный	8
M48Z35	32Kb×8	4,75	5,5	Доступно	PDIP 28	Параллельный	8
M48Z35AV	32Kb×8	3	3,6	Доступно	PDIP 28;SO 28	Параллельный	8
M48Z35Y	32Kb×8	4,5	5,5	Доступно	PDIP 28;SO 28	Параллельный	8
M48Z512A	512Kb×8	4,75	5,5	Доступно	MISC. 32	Параллельный	8
M48Z512AY	512Kb×8	4,5	5,5	Доступно	MISC. 32	Параллельный	8
M48Z58	8Kb×8	4,75	5,5	Доступно	PDIP 28	Параллельный	8
M48Z58Y	8Kb×8	4,5	5,5	Доступно	PDIP 28;SO 28	Параллельный	8

Память-SRAM

PSRAM, асинхронная, напряжение питания 1,8 В

Наименование	Объем памяти, Мбит	Организация памяти	Напряжение питания		Режим	Доступность	Время цикла чтения, нс	Корпус	Ток потребления, мА	Ток потребления в режиме Standby, мкА
			В мин	В макс						
M69AR024B	16	1024к×16бит	1,65	1,95	Асинхронный	Доступно	70	BGA 48	15	100
M69AR048B	32	2048к×16	1,65	1,95	Асинхронный	Доступно	70	BGA 48	25	100

PSRAM, асинхронная, напряжение питания 3 В

Наименование	Объем памяти, Мбит	Организация памяти	Напряжение питания		Режим	Доступность	Время цикла чтения, нс	Корпус	Ток потребления, мА	Ток потребления в режиме Standby, мкА
			В мин	В макс						
M69AW024B	16	1024к×16	2,7	3,3	Асинхронный	Доступно	60	BGA 48	20	100
M69AW048B	32	2048к×16	2,7	3,3	Асинхронный	Доступно	70	BGA 48	30	100

SRAM, 1,8 В

Наименование	Объем памяти, Мбит	Организация памяти	Напряжение питания		Режим	Доступность	Время цикла чтения, нс	Корпус	Ток потребления, мА	Ток потребления в режиме Standby, мкА
			В мин	В макс						
M68AR024D	16	1М×16 бит	1,65	1,95	Асинхронный	В разработке	70	BGA 48	25	15
M68AR128M	2	128к×16 бит	1,65	1,95	Асинхронный	В разработке	70	BGA 48	6	4
M68AR256D	4	256К×16 бит	1,65	1,95	Асинхронный	В разработке	55	BGA 48	6	8
M68AR256M	4	256К×16 бит	1,65	1,95	Асинхронный	В разработке	70	BGA 48	6	8

SRAM, 3 В

Наименование	Объем памяти, Мбит	Организация памяти	Напряжение питания		Режим	Доступность	Время цикла чтения, нс	Корпус	Ток потребления, мА	Ток потребления в режиме Standby, мкА
			В мин	В макс						
M616Z08	0,128	128 Кбит (8 Кбит×16)	2,34	3,6	–	Доступно	–	SO 44	75	1000
M68AW031A	0	32К×8 бит	2,7	3,6	Асинхронный	В разработке	55–70	SO 28;TSOP 28	30	10
M68AW127B	1	128к×8 бит	2,7	3,6	Асинхронный	Доступно	70	SO 32;TSOP 32	15	15
M68AW128M	2	128к×16 бит	2,7	3,6	Асинхронный	Доступно	55–70	BGA 48;TSOP-II 44	20	10
M68AW256D	4–32	256К×16 бит	2,7	3,6	Асинхронный	В разработке	70	TSOP-II 44	20	10
M68AW256M	4	256К×16 бит;256к×16 бит	2,7	3,6	Асинхронный	В разработке	55–70	BGA 48;TSOP-II 44	20	10
M68AW511A	4	512к×8 бит	2,7	3,6	Асинхронный	Доступно	70	SO 32;TSOP-II 32	30	10
M68AW512D	8	512К×16 бит	2,7	3,6	Асинхронный	Доступно	55	BGA 48	35	20
M68AW512M	1	512К×16 бит	2,7	3,6	Асинхронный	Доступно	70	TSOP-II 44	35	20

SRAM, 5 В

Наименование	Объем памяти, Мбит	Организация памяти	Напряжение питания		Режим	Доступность	Время цикла чтения, нс	Корпус	Ток потребления, мА	Ток потребления в режиме Standby, мкА
			В мин	В макс						
M68AF031A	0,256	32К×8 бит	4,5	5,5	Асинхронный	В разработке	55–70	SO 28;TSOP 28	50	10
M68AF127B	1	128к×8 бит	4,5	5,5	Асинхронный	Доступно	55–70	PDIP 32;SO 32;TSOP 32	15	15
M68AF511A	4	512к×8 бит	4,5	5,5	Асинхронный	Доступно	70	SO 32;TSOP-II 32	55	10